⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
　令和７年９月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　Ａ　レチクル上のパターンを縮小投影露光法によりウェハ上に微細パターンとして露光できること。
　Ｂ　ウェハ搬送系を有すること。
　Ｃ　ウェハをプリアライメントする機構を有すること。
　Ｄ　ウェハ上の既存パターンとの位置合わせが精密にできること。
　Ｅ　ウェハに対してオートフォーカスできること。
　Ｆ　20㎜角～直径８インチを含む様々な大きさのウェハに対して露光できること。ただし直径４インチより小さいウェハはこちらで支給するトレイを用いて露光してもよい。
　Ｇ　反りのあるウェハに対して露光できること。
　Ｈ　透明なウェハに対して露光できること。
　Ｉ　高スループットでウェハに露光できること。
　Ｊ　レチクル搬送系を有すること。
　Ｋ　複数枚のレチクルを収納することができ、それらの中から露光に必要なレチクルを自動でセットできること。
　Ｌ　投影縮小率は１／５であること。
　Ｍ　本装置（ＫｒＦステッパ　一式）用レチクルと、本学既存i線ステッパ（キヤノン㈱製ＦＰＡ―3030ｉ５＋）用レチクルは、それぞれの装置において相互に使用できること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和７年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　大友　將充　電話022―217―4869
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和７年３月26日から令和７年４月28日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和７年４月９日10時00分
⑵　開催場所　オンライン開催とする。（詳細は、導入説明書による。）
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the services to be required : 24
⑵　Nature and quantity of the services to be required : KrF Stepper 1 Set
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
　A　The system must be able to expose fine patterns on a reticle to a wafer by reduction projection exposure method.
　B　The system should have a wafer transfer system.
　C　The system should have a wafer prealignment system.
　D　The system must be able to align patterns to be exposed precisely with existing patterns on a wafer.
　E　The system must be able to focus on a wafer automatically.
　F　The system must be able to expose patterns on a wafer of various sizes including the range from 20㎜ square to 8-inch diameter. A tray provided by the University can be used for the wafer smaller than 4-inch.
　G　The system must be able to expose patterns on the wafer with warpage.
　H　The system must be able to expose patterns on transparent wafers.
　I　The system must be able to expose patterns with high-throughput.
　J　The system should have a reticle transfer system.
　K　The system must be able to stock reticles and to set the selected reticle automatically.
　L　The projection reduction ratio must be 1／5.
　M　The reticles for this system and the existing i-line stepper (FPA－3030i5+, Canon inc.) must be mutually compatible and interchangeable between the two systems.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　28 April, 2025
⑹　Contact point for the notice : Masamitsu Otomo, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1　Katahira　Aoba-ku　Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

○第 25 号

１　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量　多目的ドライエッチャー　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　第24号に同じ。
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　Ａ　ウェハ搬送系を有すること。
　Ｂ　試料交換室を有し、プロセスチャンバと試料交換室とのウェハのやり取りは、真空下で行えること。
　Ｃ　試料交換室にはウェハカセットを有し、自動で10枚以上連続処理ができること。
　Ｄ　20㎜角～直径８インチを含む様々な大きさのウェハに対してエッチング処理ができること。
　Ｅ　４インチ（ＪＥＩＴＡ／ＳＥＭＩ）、６インチ（ＪＥＩＴＡ／ＳＥＭＩ）及び８インチウェハ（ノッチ）は、それぞれウェハカセットを用いて自動搬送に対応すること。
　Ｆ　エッチングガスは、少なくとも塩素系、フッ素系、アルゴン、酸素及び窒素が使用できること。
　Ｇ　圧電材料のニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３：ＬＮ）ウェハ、タンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ３）ウェハ、石英ウェハ及び炭化ケイ素（ＳｉＣ）ウェハなどの難エッチング材を高スループットで、異方性エッチングできること。また、パターンサイズが100～500nm程度の時、高アスペクト比の異方性エッチングができること。なお、それぞれの参考データを提出すること。
　Ｈ　エッチング時のプラズマは低圧で発生し、かつ高密度であること。
　Ｉ　エッチング時のプロセス圧力は、１Pa以下で行えること。
　Ｊ　ウェハ上のバイアス電圧とプラズマ密度は、それぞれ独立に制御できること。
　Ｋ　８インチウェハ内のエッチング分布は、５％以内であること。
　Ｌ　発光分光により、プロセスのモニタリング（エッチング終了検知）ができること。
　Ｍ　エッチングチャンバは、後に追加できる構造であること。
　Ｎ　エッチング時の装置状態である各種測定値のログは、可読出来る形式で出力できること。
　Ｏ　プロセスレシピは、可読出来る形式で出力できること。
　Ｐ　制御系はＬＡＮに接続でき、ログファイルやレシピファイルがＬＡＮを通して出力できること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和７年４月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　第24号に同じ。
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和７年３月26日から令和７年４月28日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和７年４月９日11時00分
⑵　開催場所　オンライン開催とする。（詳細は、導入説明書による。）
５　第24号に同じ。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Multi-Purpose Dry Etcher 1 Set